#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

#### (43) 国際公開日 2004年2月26日(26.02.2004)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 2004/017349 A1

(51) 国際特許分類7:

H01H 51/24, 50/18, B81B 3/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/009724

(22) 国際出願日:

2003年7月31日(31.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-223845

2002年7月31日(31.07.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下 電工株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS, LTD.) [JP/JP]; 〒571-8686 大阪府 門真市大字門真 1048 番地 Osaka (JP).

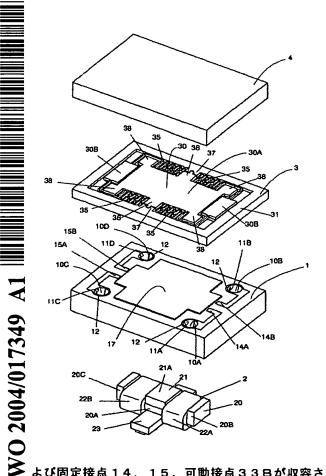
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 境 浩司 (SAKAI,Kouji) [JP/JP]; 〒571-8686 大阪府 門真市大 字門真 1048番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 榎 本 英樹 (ENOMOTO, Hideki) [JP/JP]; 〒571-8686 大阪 府 門真市大字門真 1048番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 奥村 直樹 (OKUMURA, Naoki) [JP/JP]; 〒 571-8686 大阪府 門真市大字門真 1048番地 松下電工 株式会社内 Osaka (JP). 下村 勉 (SHIMOMURA, Tsutomu) [JP/JP]; 〒571-8686 大阪府 門真市大字門真 1048番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP). 堀 正美 (HORI,Masami) [JP/JP]; 〒571-8686 大阪府 門真市大 字門真 1048番地 松下電工株式会社内 Osaka (JP).

/続葉有/

(54) Title: MICRO-RELAY

(54) 発明の名称: マイクロリレー



(57) Abstract: A micro-relay comprising a body (1), an armature block (3) and a cover (4). The body (1) is provided with an electromagnet mechanism (2) and is formed of either silicon or glass. The cover is also formed of either silicon or glass. The armature block (3), formed of silicon, is integrally provided with an armature substrate (30) and a frame (31) that surrounds the entire periphery of the armature substrate (30) to rockingly support the substrate (30). The armature substrate (30) is provided on the lower surface thereof with a magnetic element (32) to constitute an armature (300). When the armature (300) rocks, fixed contacts (14A, 14B, 15A, 15B) contact or separate from a movable contact (33B). When the frame (31) is directly connected along the entire periphery thereof with the peripheral edge (19) of the body (1) and the peripheral edge (41) of the cover (4), an enclosed space surrounded by the frame (31) is formed between the body (1) and the cover (4). The armature (300), and fixed contacts (14, 15) and the movable contact (33B) are housed in this enclosed space.

(57) 要約: このマイクロリレーは、ボディ1と、アーマチュ アブロック3と、カバー4とを備える。ボディ1は電磁石 機構2を備え、シリコンとガラスの何れか一方で形成され る。カバー4も、シリコンとガラスの何れか一方で形成さ れる。アーマチュアブロック3は、シリコンで形成され、 アーマチュア基板30とこのアーマチュア基板30の全周 を包囲してアーマチュア基板30を揺動自在に支持するフ レーム31とを一体に備える。アーマチュア基板30は、 下面に磁性体32が備えられてアーマチュア300を構成 する。アーマチュア300の揺動により固定接点14A, 14B, 15A, 15Bと可動接点33Bとが接離する。 そして、フレーム31がその全周にわたってボディ1の周縁 部19とカパー4の周縁部41とに直接接合することで、 ボディ1とカバー4との間でフレーム31に囲まれた密閉空 間が形成され、この密閉空間内に、アーマチュア300お

よび固定接点14,15、可動接点33Bが収容されている。

- (74) 代理人: 西川 惠清,外(NISHIKAWA, Yoshikiyo et al.); 〒530-0001 大阪府大阪市北区 梅田1丁目12番17号 梅 田第一生命ビル 5 階 北斗特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### - 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

#### 明細書

#### マイクロリレー

#### 技術分野

本発明は、半導体微細加工技術を用いて形成されたマイクロリレーに 関するものである。特に、接点機構が密閉空間内で動作する密閉式のマイクロリレーに関する。

#### 背景技術

10 一般にマイクロリレーは、電磁石機構と、アーマチュアと、上記アーマチュアの揺動により固定接点と可動接点とが接離する接点機構とを備える。マイクロリレーは、固定接点や可動接点にゴミや埃が付着するのを防止したり、接点の開閉性能を向上させるために、上記接点機構を密閉空間内に配置して使用するのが好ましい。そのため、従来のマイクロリレーは、ボディとカバーとで形成された空間内にアーマチュアおよび接点機構を収容し、ボディとカバーとをシール剤で封止していた。

しかしながら、マイクロリレーの小型化が進むとシール剤で封止するのが困難となり、またシール剤のコストやシール工程に要する時間も無駄であった。

20

#### 発明の開示

本発明は上記の問題点を解決するために為されたものであって、小型

10

15

20

で容易に作製できる密閉式のマイクロリレーを提供することを目的とする。

本発明にかかるマイクロリレーは、ボディと、カバーと、アーマチュアブロックと、接点機構とを備える。上記ボディは電磁石機構を備え、シリコンとガラスの何れか一方で形成される。上記カバーも、シリコンとガラスの何れか一方で形成される。上記アーマチュアブロックは、シリコンで形成され、アーマチュア基板とこのアーマチュア基板の全周を包囲してアーマチュア基板を揺動自在に支持するフレームとを一体に備える。上記アーマチュア基板は、表面に磁性体が備えられてアーマチュアを構成する。上記接点機構は、上記アーマチュアの揺動により固定接点と可動接点とが接離する。そして、上記フレームがその全周にわたって上記ボディの周縁部と上記カバーの周縁部とに直接接合することで、上記ボディと上記カバーとの間で上記フレームに囲まれた密閉空間が形成され、この密閉空間内に、上記アーマチュアおよび上記接点機構が収容されている。

従って、このマイクロリレーは、上記ボディと上記カバーとが上記フレームに直接接合されているため、上記ボディとカバーとをシール剤を用いて封止することなく、上記アーマチュアおよび上記接点機構を密閉空間内に収容することができる。上記ボディと上記フレームおよび上記カバーと上記フレームとの接合は、シリコンとガラス、または、シリコンとシリコンとの接合となるので、既知の接合方法を用いて容易に接合することができる。また、シリコンやガラスの加工に半導体微細加工技

術を用いることで、容易に小型化することもできる。

上記電磁石機構は、通電した時に生じる磁界の磁路を形成するヨークを備え、上記ボディは、その上下両面に貫通するように形成された貫通 孔を有し、ボディの上面側で上記貫通孔を閉じる薄膜が設けられてボディの下面側に上記ヨークを収容する収容凹部が形成されるのが好ましい。上記薄膜は、シリコンとガラスの何れか一方で形成され、上記ボディと 密着接合することで上記密閉空間を上記収容凹部から遮断する。

この場合、上記収容凹部と上記密閉空間とは上記薄膜のみで隔てられているため、上記収容凹部に収容された上記ヨークと上記密閉空間内に収容された上記アーマチュアとの磁気ギャップを小さくすることができ、上記密閉空間の気密性を保ったまま電磁石機構の吸引力を大きくすることができる。また、薄膜の厚さを調節することで、吸引力を調節することできる。

15

20

10

5

また、上記ボディは、その上下両面に貫通するスルーホールと、上記 スルーホール内に形成されマイクロリレーを実装するプリント基板の電 気回路および上記密閉空間内の接点機構を電気接続するための電気経路 と、上記スルーホールの開口を閉塞する閉塞手段とを備えるのも好まし い。

この場合、上記電気経路を介して上記接点機構とマイクロリレーを実 装するプリント基板の電気回路とを容易に電気接続することが可能とな り、さらに、上記閉塞手段を設けることで、上記密閉空間内の気密性を 保つこともできる。

上記閉塞手段を、上記スルーホールの下面開口に設けられたバンプと すると、上記スルーホールを閉塞しながら、プリント基板にフリップチ ップ接合を用いてマイクロリレーを実装することが可能となる。

また、上記アーマチュア基板の肉厚は上記フレームの肉厚よりも小さく、上記フレームの下面に対して上記アーマチュアの下面が凹むようにアーマチュア基板がフレームに保持されて、上記アーマチュアの下面と上記ボディとの間に、アーマチュアの揺動を収容する空間を形成するのが好ましい。

この場合、上記ボディと上記アーマチュア基板とを接合するだけで、 上記アーマチュアの下面と上記ボディとの間にアーマチュアの揺動を収 容する空間を確保できる。

15

20

10

5

また、上記アーマチュア基板は、弾性変形可能な弾性片によって上記フレームに支持されており、上記弾性片は、一端が上記アーマチュア基板に一体に形成結合されると共に他端が上記フレームに一体に形成結合され、上記一端と上記他端との間に上記フレームと同一平面で蛇行する蛇行部を有するのも好ましい。

この場合、限られた上記フレーム内の空間において上記弾性片を長く 形成することができ、上記アーマチュア基板がシーソー動作する時に上 記弾性片がねじられることで生じるばね力のばね定数を適切に小さくできる。上記弾性片に加えられる応力も分散できる。

上記蛇行部は、少なくとも1つのU字形の形状を含む形とすれば、上 記弾性片を効率的に長く形成することができる。

5

10

さらに、上記アーマチュア基板と上記ボディの対向面のうち何れか一方に突起部を形成し、上記アーマチュア基板は、上記突起部の頂点を支点としてシーソー動作するのが好ましい。この場合、上記アーマチュア基板は、上記突起部を介してボディにも支持されるので、安定してシーソー動作することができる。また、上記突起部が上記アーマチュアと上記ボディとの間に設けられているので、電磁石機構の吸引力が強くて上記アーマチュア全体がボディに吸着され揺動しなくなる事態を防止できる。

### 15 図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1の実施形態に係るマイクロリレーの分解斜視図である。

図2は、同上を下側からみた斜視図である。

図3は、同上のボディの分解斜視図である。

20 図4と図5は、同上の薄板とヨークとの嵌合を示す模式図である。

図6は、同上のアーマチュアブロックを下側から見た分解斜視図である。

図7は、同上のアーマチュアブロックを上側からみた図である。

- 図8は、同上のカバーを開けた状態の分解斜視図である。
- 図9は、同上の断面図である。
- 図10は、同上の電磁石機構の別の構成を示す図である。
- 図11は、同上の突起部の別の構成を示す図である。
- 5 図12は、同上の蛇行部の別の構成を示す図である。
  - 図13は、本発明の第2の実施形態に係るマイクロリレーの分解斜視図である。
  - 図14は、同上を下側から見た分解斜視図である。
  - 図15は、同上のボディの別の構成を示す図である。
- 10 図16は、本発明の第3の実施形態に係るマイクロリレーの分解斜視図 である。
  - 図17は、同上をカバーを下にして見た分解斜視図である。
  - 図18は、同上の断面図である。

#### 15 発明を実施するための最良の形態

本発明を詳細に説明するために、添付の図面に従ってこれを説明する。 図1に、本発明の第1の実施形態に係るマイクロリレーを示す。この マイクロリレーは、ボディ1と、電磁石機構2と、アーマチュアブロッ ク3と、カバー4とを備える。

20 ボディ1は、矩形板状のガラス基板であって、四隅の近傍には、ボディ1の上下両面に貫通したスルーホール10A, 10B, 10C, 10 Dが形成されている。各スルーホール10A~10Dの内周面には、マ イクロリレーを実装するプリント基板の電気回路(図示せず)と後述する固定接点とを電気接続するための電気経路11A~11Dが形成されている。各電気経路11A~11Dは、クロム、チタン、白金、コバルト、ニッケル、金、金とコバルトの合金、又はこれらの合金等からなり、めっき、蒸着、スパッタ等により形成されている。各スルーホール10A~10Dの両端の開口部周縁には、各電気経路11A~11Dと電気接続されたランド12が形成されている。図2に示すように、ボディ1の下面側のランド12には、金、銀、銅、半田などの導電性材料からなるバンプ13が載せられ、各スルーホール10A~10Dの下面開口を塞ぐように、熱などで密着接合されている。

5

10

15

20

ボディ1の上面には、2対の固定接点14A,14B、15A,15Bは、 Bが形成されている。各固定接点14A,14B,15A,15Bは、 少なくともその表面が、クロム、チタン、白金、コバルト、ニッケル、 金、金とコバルトの合金、又はこれらの合金等により形成されている。 固定接点14A,14Bは、2つのスルーホール10A,10Bに挟まれるようにして並設されている。そして、一方の固定接点14Aは、スルーホール10Aのランド12と電気接続され、他方の固定接点14Bはスルーホール10Bのランド12と電気接続されている。同様に、固定接点15A,15Bは、2つのスルーホール10C,10Dに挟まれるようにして並設され、一方の固定接点15Aは、スルーホール10Cのランド12と電気接続されている。

10

15

20

ボディ1の中央には、図3に示すように、ボディ1の上下両面に貫通した十字形の貫通孔16が設けられ、薄膜17がボディ1の上面側で貫通孔16を閉じるようにボディ1に密着接合されている。これにより、ボディ1の下面側に電磁石機構2を収納する収容凹部18が形成される(図2参照。)。薄膜17は、シリコンまたはガラスで形成され、エッチングまたは研磨などの加工を施すことで5~50μm程度、好ましくは20μm程度の厚さに形成される。

電磁石機構2は、ヨーク20と、永久磁石21と、コイル22A,2 2 B と、基板 2 3 とからなる。ヨーク 2 0 は、電磁軟鉄などの鉄板を曲 げ加工あるいは鍛造加工することにより、矩形板状の中央片20Aの両 端から、矩形板状の脚片20B,20Cがそれぞれ立ち上がった形状に 形成されている。永久磁石21は、直方体形状であって、背中合わせの 磁極面21A。21B(磁極面21Bは、図示せず。)が互いに異極と なるように着磁されている。永久磁石21は、一方の磁極面21Bがヨ ーク20の中央片20Aの中央に当接し、他方の磁極面21Aが脚片2 0 B, 20 Cの先端と同じ高さになるようにヨーク20 に取着されてい る。コイル22A,22Bは、脚片20B,20Cと永久磁石21との 間で、中央片20Aに直接巻回される。基板23は矩形状であり、ヨー ク20の中央片20Aの下面に中央片20Aと直交するように接合され る。基板23は、下面に導電部23Aを有し(図2参照)、コイル22 の末端が導電部23Aに電気接続されている。導電部23Aには、マイ クロリレーを実装するプリント基板の電気回路(図示せず)とコイル2

10

15

20

2とを電気接続するバンプ24が設けられている。

電磁石機構2は、脚片20B,20Cの先端を上向きにして、収容凹部18に収容される。この時、図4または図5に示すように、薄膜17の下面には凹部または凸部からなる位置決め部17Aが形成されており、電磁石機構2は、脚片20Bの先端および永久磁石21の磁極面21Aを位置決め部17Aに凹凸嵌合させることで、収容凹部18に精確に位置決めされて収容される。

アーマチュアブロック 3 は、5 0~3 0 0 μ m程度、好ましくは2 0 0 μ m程度の厚みを有するシリコン基板をエッチングして形成され、アーマチュア基板3 0 と、アーマチュア基板3 0 の全周を包囲してアーマチュア基板3 0 を揺動自在に支持するフレーム3 1 とを一体に備える。アーマチュア基板3 0 の下面には、図6 に示すように矩形板状の磁性体3 2 が接合され、アーマチュア基板3 0 と磁性体3 2 とでアーマチュア3 0 0 を構成する。

アーマチュア基板30は、図6および図7に示すように、下面に磁性体32が接合される矩形状の磁性体保持部30Aと下面に可動接点33A,33Bが固着される可動接点部30Bとからなる。可動接点部30Bは、磁性体保持部30Aの長手方向の両側において、弾性変形可能なヒンジ片34によって磁性体保持部30Aに支持されている。

磁性体保持部30Aは、幅方向の両側が、弾性変形可能な弾性片35 によってフレーム31に支持されている。弾性片35は、アーマチュア 基板30のシーソー動作の軸Xを中心として、線対称に4ヶ所設けられ

10

15

ている。各弾性片 3 5 は、一端が磁性体保持部 3 0 A に一体に形成結合されると共に他端がフレーム 3 1 に一体に形成結合されており、上記一端と上記他端との間に、フレーム 3 1 と同一平面上で U字形に多数蛇行した蛇行部 3 5 A が形成されている。

また、磁性体保持部30Aは、幅方向の両側の中央部に延設片36が 形成されている。延設片36のフレーム31に対向する部位には凸部3 6Aが設けられ、凸部36Aに対向するフレーム31の内周面には凹部 37Aを有する延設片37が設けられる。凸部36Aと凹部37Aとは、フレーム31と同一平面で凹凸嵌合することにより、アーマチュア基板30の水平方向の移動を規制する移動規制部301を構成する。さらに、延設片36の下面には、アーマチュア基板30のシーソー動作の支点となる突起部36Bが形成されている。

さらに、磁性体保持部30Aの四隅には、第2の延設片38が形成されている。第2の延設片38の下面には、アーマチュア基板30のシーソー動作のストッパーとなる第2の突起部38Aが形成されている。

磁性体32は、電磁軟鉄、電磁ステンレス、パーマロイなどの磁性材料を機械加工して形成され、接着、溶接、熱着、ロウ付けなどの方法で、磁性体保持部30Aに接合される。

アーマチュア基板30の肉厚は、フレーム31の肉厚よりも小さく形20 成されており、フレーム31の下面に対してアーマチュア300の下面(すなわち、磁性体32の下面および可動接点33A,33Bの下面。)が凹むようにアーマチュア基板30がフレーム31の上側に保持

されている。これにより、後述するように、フレーム31をボディ1に 接合した際に、アーマチュア300の下面とボディ1との間に、アーマ チュア300の揺動を収容する空間が形成される。

カバー4は、パイレックス(R)のような耐熱ガラスにより矩形板状に形成され、下面には、図8に示すように、アーマチュア300の揺動を収容するための凹部40が設けられている。

5

10

15

20

上述のように構成されたボディ1、アーマチュアブロック3、カバー4は、アーマチュアブロック3のフレーム31がその全周にわたってボディ1の周縁部19とカバー4の周縁部41とに、陽極接合などの方法で直接接合される。そして、図9に示すように、ボディ1とカバー4との間でフレーム31に囲まれた密閉空間Sが形成され、密閉空間S内にアーマチュア300および可動接点33A,33Bおよび固定接点14A,14B,15A,15Bが収容される。可動接点33A,33Bと、固定接点14A,14B,15A,15Bとは、アーマチュア300の揺動により接離する接点機構302を構成する。アーマチュアブロック3の突起部36Bは、その頂点が薄膜17に当接している。

次に、このマイクロリレーの動作について説明する。

コイル22A, 22Bに一方向から通電すると、磁性体32が一方の脚片20Bに吸引され、アーマチュア300は、突起部36Bの頂点を支点として、シーソー動作を行う。アーマチュア300のシーソー動作は、第2の延設片38の下面に設けられたストッパーとしての第2の突起部38Aがボディ1の上面に当接することで止まる。この時、可動接

10

15

点部30Bの下面に設けられた可動接点33Aは、対向する一対の固定接点14A,14Bと当接し、固定接点14A,14B間を閉じる。可動接点33Aは、ヒンジ片34の弾性により、適度な接点圧を得ている。コイル22A,22Bの通電を停止しても、永久磁石21から発生され磁性体32→脚片20B→永久磁石21という閉磁路を通る磁束により、アーマチュア300は、同一状態を維持している。

次に、コイル22A,22Bの通電方向を逆にすると、磁性体32が他方の脚片20Cに吸引され、弾性片35のねじり復帰力も加わって、アーマチュア300は、突起部36Bの頂点を支点として、反対方向にシーソー動作を行う。この時、可動接点部30Bの下面に設けられた可動接点33Bは、対向する一対の固定接点15A,15Bと当接し、固定接点15A,15B間を閉じる。可動接点33Bは、ヒンジ片34の弾性により、適度な接点圧を得ている。コイル22A,22Bの通電を停止しても、永久磁石21から発生され磁性体32→脚片20C→永久磁石21という閉磁路を通る磁束により、アーマチュア300は、同一状態を維持している。すなわち、本実施形態のマイクロリレーは、常開接点と常閉接点とを一組づつ備えたラッチング型のリレーとして構成されている。

上述したように、本マイクロリレーの構成によると、ボディ1とカバ20 -4とを、アーマチュアプロック3を挟むようにしてフレーム31に直接接合することで、密閉式のマイクロリレーを容易に作製できる。通常の半導体製造プロセスと同様に、ウエハ上に多数のボディ1を形成し、

別のウエハ上に多数のアーマチュアプロック3を形成し、さらに別のウエハ上に多数のカバー4を形成し、それらのウエハを重ね合わせるようにして、同時に多数のマイクロリレーを形成するのが望ましい。ボディ1やアーマチュアプロック3、カバー4の加工は、半導体微細加工技術を用いることで容易に小型化が可能である。マイクロリレーをプリント基板(図示せず)に実装するには、ボディ1の下面のバンプ13およびバンプ24をフリップチップ接合すればよい。

5

10

15

20

なお、アーマチュア300は、突起部36Bがあることによりボディ1に吸着されることないので、弾性片35のばね定数を自由に小さく設定することもできる。突起部36Bを設けたことで、アーマチュア300個動が格段によくなった。

また、ストッパーとして第2の突起部38Aを設けることで、磁性体32と薄膜17とが直接衝突し磁性体32または/および薄膜17が破損する事態を防止している。第2の突起部38Aとボディ1との距離を調節することで、可動接点33A,33Bの押し込み量も調節できる。

また、カバー4にアーマチュア300の揺動を収容するための凹部4 0を設けたように、ボディ1にもアーマチュア300の揺動を収容する ための凹部を設けると、ボディ1は収容凹部18のスペースを確保する 必要もあるためボディ1を大きくせざるを得ないが、本マイクロリレー ではボディ1に凹部を設ける必要がないため、より小型化できる。

また、本実施形態では、永久磁石21を用いた有極型の電磁石機構2

を示したが、図10に示すように、永久磁石を用いない無極型の電磁石 機構2を用いても良い。

また、本実施形態では、突起部36Bをアーマチュア基板30の下面 (延設片36の下面)に設けたが、突起部36Bの替わりに、図11に 示すように、薄膜17の上面に突起部17Bを設け、アーマチュア基板 30が突起部17Bの頂点に当接してシーソー動作するようにしても良い。

また、本実施形態では、ボディおよびカバーはガラスで形成したが、 シリコンで形成しても良い。

また、蛇行部35Aの形状は、例えば、図12(a)~(e)に示すような形状でもよい。蛇行部35Aの幅や形状は、弾性片35に要求されるばね定数の大きさに応じて決定すればよい。その時、蛇行部35Aの長さを長く形成しておくと、弾性片35に加えられる応力を分散できる。

15

20

10

5

図13に、本発明の第2の実施形態に係るマイクロリレーを示す。このマイクロリレーは、コイルがボディの表面に形成されたタイプであり、第1の実施形態と共通する箇所には同じ符号を付して説明を省略する。

コイル22A, 22Bは、ガラスからなるボディ1の表面に螺旋形の配線パターンをパターニングして形成されており、それぞれの末端の一方同士が接続されると共に、コイル22Aの他方の末端がスルーホール10Dのランド12に接続され、コイル22Bの他方の末端がスルーホ

ール10Cのランド12に接続されている。コイル22A, 22Bは、フォトリソグラフィによりアルミの薄膜を形成する工程と、TEOSを反応源とするCVD法により上記アルミの薄膜上に絶縁膜(酸化シリコン膜)を形成する工程とを繰り返すことで、積層構造を有するように形成される。

5

10

15

20

ボディ1の下面には、図14に示すように、ヨーク20および永久磁石21を収容する収容凹部18が、ブラスト加工により形成されている。

アーマチュア基板30は、シリコンからなる矩形板状であり、上面全体にスパッタ、蒸着、めっき等の方法で磁性体32が形成されて、アーマチュア300を構成している。アーマチュア基板30の下面には、長手方向の一端部に矩形板状の可動接点33Aが固着されている。アーマチュア基板30は、幅方向の両側で長手方向の中心が弾性片35によってフレーム31に支持されている。アーマチュア基板30の肉厚および弾性片35の肉厚は、フレーム31の肉厚よりも小さく形成されており、フレーム31の下面に対してアーマチュア300の下面が凹むようにアーマチュア基板30がフレーム31の上側に保持されている。アーマチュア300は、弾性片35を軸としてシーソー動作を行う。

ボディ1、アーマチュアブロック3、カバー4は、第1の実施形態と 同様に、アーマチュアプロック3のフレーム31がその全周にわたって ボディ1の周縁部19とカバー4の周縁部41とに直接接合され、接点 を一組備えた密閉式のマイクロリレーを構成する。

このように、コイル22A, 22Bをボディ1の表面に直接形成する

10

15

20

ことで、より小型化したマイクロリレーを作製できる。

なお、スルーホール10A~10Dは、パンプ13により閉塞されているが、例えば、フリップチップ接合の際に溶融したパンプ13とランド12との間に隙間が生じる恐れがある場合は、図15に示すように、閉塞手段としての蓋体5を新たに設けて、スルーホール10A~10Dの上面開口を閉塞するようにしてもよい。蓋体5は、アーマチュアブロック3の形成時に、シリコン基板から分離して形成するのが好ましい。

図16は、本発明の第3の実施形態に係るマイクロリレーを示す。第2の実施形態のマイクロリレーのようにコイルをボディ上に形成すると、リレーを小型化できるものの、第1の実施形態のように巻線を巻回したマイクロリレーと比較して、吸引力が低下しがちである。そこで本実施形態では、固定接点をボディではなくカバーに形成することで、巻線と固定接点とが干渉することなく巻線を大きく形成できるようにした。第1または第2の実施形態と共通する箇所には同じ符号を付して説明を省略する。

ボディ1の上面には、コイル22A,22Bおよび電極パッド6A,6Bが形成されている。電極パッド6A,6Bは、コイル22Bの幅方向の両側に設けられている。それぞれコイル22A,22Bの末端の一方同士が接続されると共に、コイル22Aの他方の末端が電極パッド6Aに接続され、コイル22Bの他方の末端が電極パッド6Bに接続されている。

WO 2004/017349 PCT/JP2003/009724

アーマチュア基板30は、上面の長手方向の一端部に矩形板状の可動接点33Aが固着され、図17に示すように、下面には磁性体32が形成されている。アーマチュア基板30の肉厚および弾性片35の肉厚はフレーム31の肉厚よりも小さく形成されており、フレーム31の下面および上面に対してアーマチュア300の下面および上面が凹むように、アーマチュア基板30がフレーム31の高さ方向の中央に保持されている。

5

10

15

20

カバー4の四隅の近傍には、カバー4の上下両面に貫通したスルーホール10A~10Dが形成されている。各スルーホール10A~10Dの内周面には、第1および第2の実施形態と同様に電気経路11A~11Dが形成され、各スルーホール10A~10Dの両端の開口部周縁には、ランド12が形成されている。カバー1の上面側のランド12には、各スルーホール10A~10Dの上面開口を塞ぐように、バンプ13が密着接合されている。

カバー4の下面には、2つのスルーホール10C, 10Dに挟まれるようにして、一対の固定接点14A, 14Bが形成されている。一方の固定接点14Aは、スルーホール10Cのランド12と電気接続され、他方の固定接点14Bはスルーホール10Dのランド12と電気接続されている。また、カバー4の下面には、電極パッド7A, 7Bが形成されている。一方の電極パッド7Aは、スルーホール10Aとスルーホール10Cとの間でスルーホール10Aの近傍に設けられ、スルーホール10Aのランド12と電気接続されている。他方の電極パッド7Bは、

10

15

スルーホール 1 0 B とスルーホール 1 0 D との間でスルーホール 1 0 B の近傍に設けられ、スルーホール 1 0 B のランド 1 2 と電気接続されている。そして、電極パッド 7 A 、7 B のそれぞれの表面には、銅からなる金属バンプ 8 が形成されている。

上述のように構成されたボディ1、アーマチュアブロック3、カバー4は、第1および第2の実施形態と同様に、アーマチュアブロック3のフレーム31がその全周にわたってボディ1の周縁部19とカバー4の周縁部42とに直接接合される。この時、金属バンプ8の先端は、アーマチュア300とフレーム31との間を通過して、ボディ1に設けられた電極パッド6A,6Bにそれぞれ接触する。これにより、スルーホール10A,10Bから、金属バンプ8を介してコイル22A,22Bに通電することが可能となる。そして、コイル22A,22Bと、固定接点14A,14Bが別々の基板に形成されているため、コイル22A,22Bを大きく形成して、吸引力を向上させることが容易にできる。マイクロリレーをプリント基板(図示せず)に実装するには、図18に示すように、カバー4を下側にして、バンプ13をフリップチップ接合すればよい。

#### 請求の範囲

5

10

15

20

1. 以下の構成を備えたマイクロリレー;

電磁石機構を備えたボディ、このボディはシリコンとガラスの 何れか一方で形成される、

シリコンとガラスの何れか一方で形成されたカバー、

シリコンで形成されたアーマチュアブロック、このアーマチュアブロックは、アーマチュア基板とこのアーマチュア基板の全周を包囲してアーマチュア基板を揺動自在に支持するフレームとを一体に備え、上記アーマチュア基板は表面に磁性体が備えられてアーマチュアを構成する、

上記アーマチュアの揺動により固定接点と可動接点とが接離する接点機構、

上記フレームがその全周にわたって上記ボディの周縁部と上記カバーの 周縁部とに直接接合することで、上記ボディと上記カバーとの間で上記 フレームに囲まれた密閉空間が形成され、この密閉空間内に、上記アー マチュアおよび上記接点機構が収容された。

2. 請求項1に記載のマイクロリレーにおいて、

上記電磁石機構は、通電した時に生じる磁界の磁路を形成するヨークを 備え、

上記ボディは、その上下両面に貫通するように形成された貫通孔を有し、 ボディの上面側で上記貫通孔を閉じる薄膜が設けられてボディの下面側 に上記ヨークを収容する収容凹部が形成され、上記薄膜は、シリコンと ガラスの何れか一方で形成され、上記ボディと密着接合することで上記 密閉空間を上記収容凹部から遮断する。

5 3. 請求項1に記載のマイクロリレーにおいて、

上記ボディは、その上下両面に貫通するスルーホールと、上記スルーホール内に形成されマイクロリレーを実装するプリント基板の電気回路および上記密閉空間内の接点機構を電気接続するための電気経路と、上記スルーホールの開口を閉塞する閉塞手段とを備えた。

10

4. 請求項3に記載のマイクロリレーにおいて、

上記閉塞手段は、上記スルーホールの下面開口に設けられたバンプである。

15 5. 請求項1に記載のマイクロリレーにおいて、

上記アーマチュア基板の肉厚は上記フレームの肉厚よりも小さく、上記フレームの下面に対して上記アーマチュアの下面が凹むようにアーマチュア基板がフレームに保持されて、上記アーマチュアの下面と上記ボディとの間に、アマチュアの揺動を収容する空間を形成する。

20

6. 請求項1に記載のマイクロリレーにおいて、

上記アーマチュア基板は、弾性変形可能な弾性片によって上記フレーム

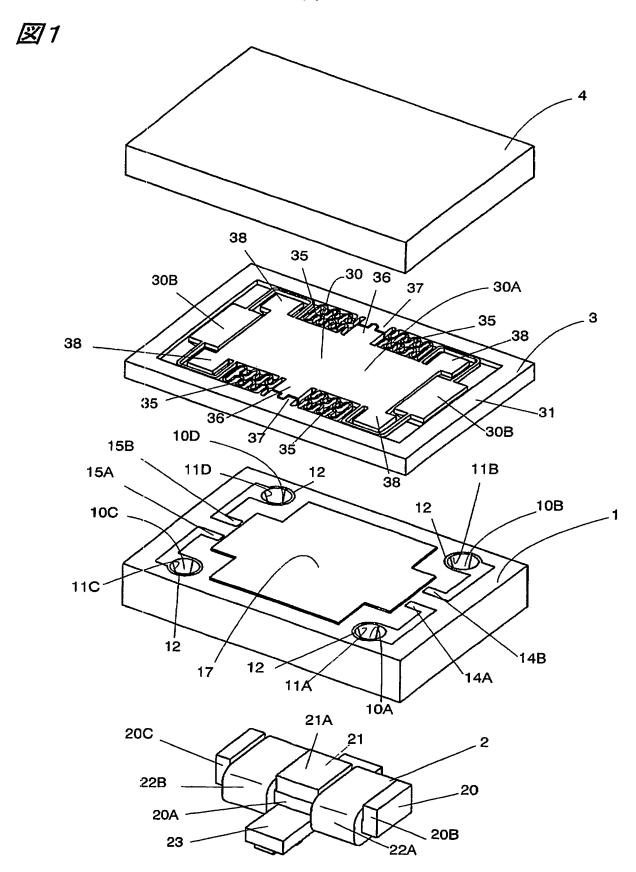
に支持されており、上記弾性片は、一端が上記アーマチュア基板に一体 に形成結合されると共に他端が上記フレームに一体に形成結合され、上 記一端と上記他端との間に上記フレームと同一平面で蛇行する蛇行部を 有する。

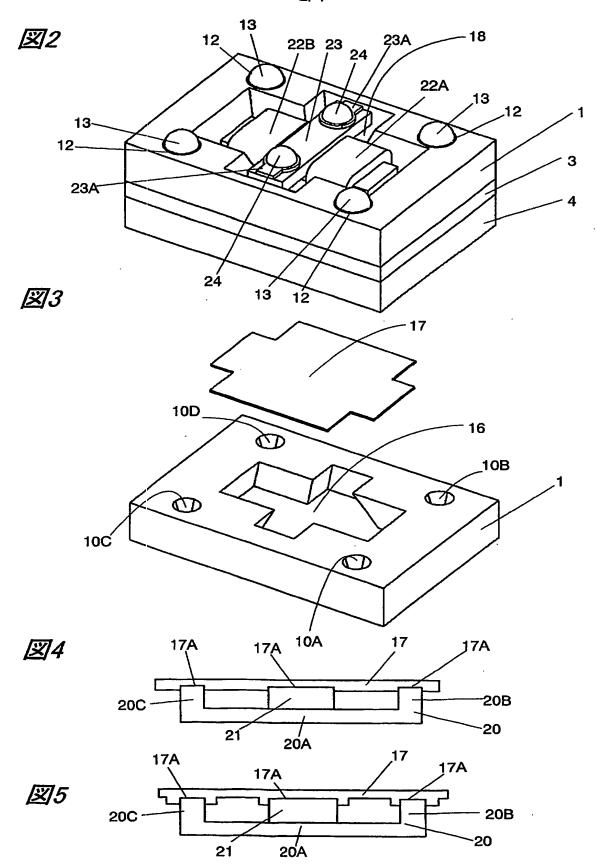
5

- 7. 請求項6に記載のマイクロリレーにおいて、
- 上記蛇行部は、少なくとも1つのU字形の形状を含む。
- 8. 請求項1に記載のマイクロリレーにおいて、
- 10 さらに、上記アーマチュア基板と上記ボディの対向面のうち何れか一方に突起部を形成し、

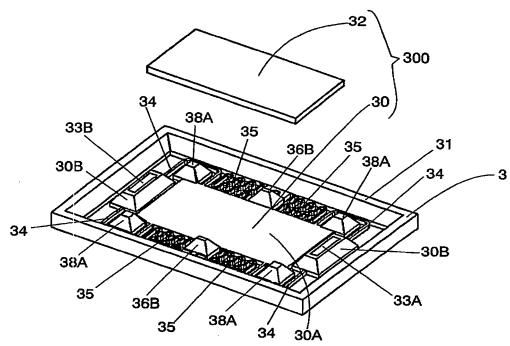
上記アーマチュア基板は、上記突起部の頂点を支点としてシーソー動作 する。

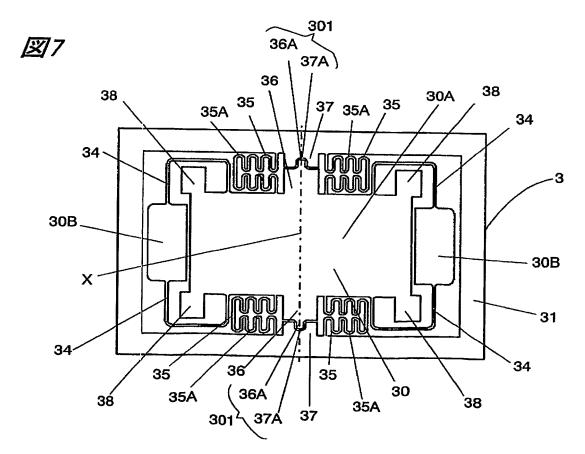
15











WO 2004/017349 PCT/JP2003/009724

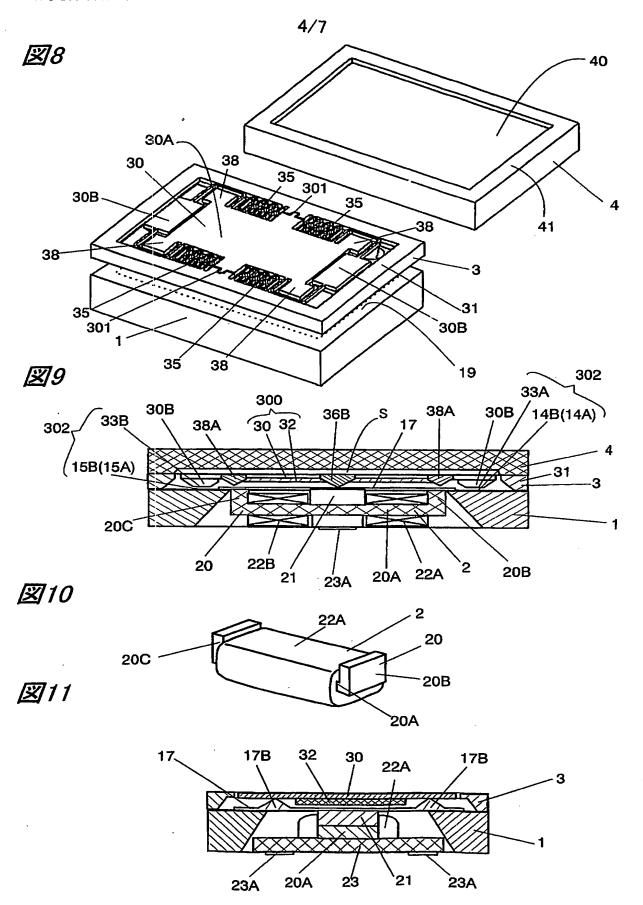
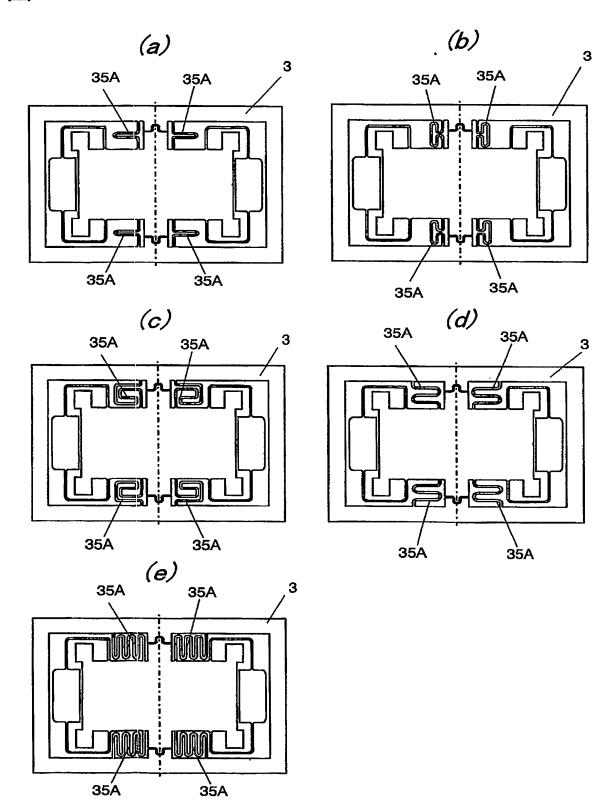
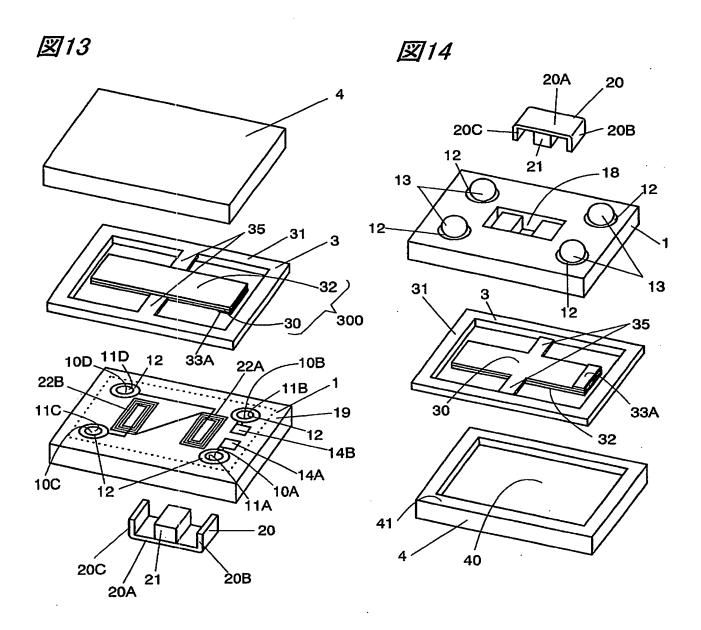
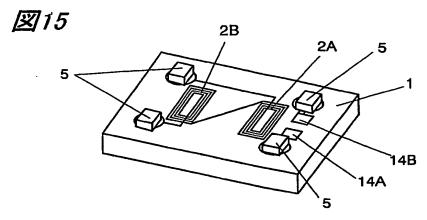
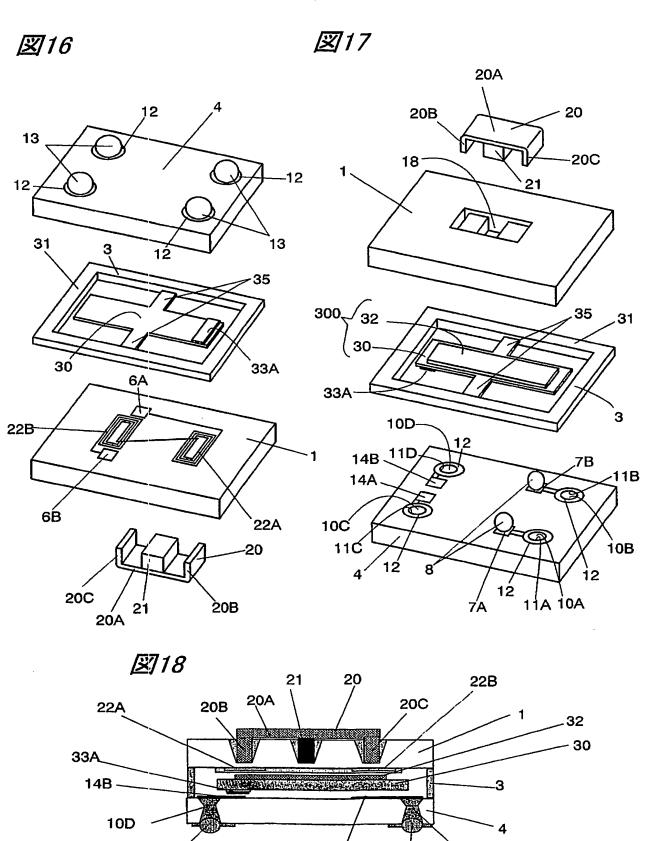


図12









10A

13

,7B

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/09724

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H01H51/24, H01H50/18, B81B3/00							
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>7</sup> H01H50/00-59/00, B81B3/00							
Jits	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)							
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Y A	JP 6-84441 A (Masayoshi EZAS Co., Ltd.), 25 March, 1994 (25.03.94), Full text; all drawings (Family: none)	HI, The Nippon Signal	1,3-8 2				
У	JP 7-176255 A (The Nippon Si Masayoshi EZASHI), 14 July, 1995 (14.07.95), Par. Nos. [0012] to [0015], [ Figs. 1 to 4, 15 to 16 & WO 95/17760 A1 & EP	1,3-8					
Y	JP 7-193160 A (NEC Corp.), 28 July, 1995 (28.07.95), Par. Nos. [0012] to [0016] (Family: none)	4					
X Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report  09 December, 2003 (09.12.03)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/09724

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 63-175450 A (Hitachi, Ltd.), 19 July, 1988 (19.07.88), Page 3, upper left column, lines 3 to 8 (Family: none)	4
Y	JP 2001-76605 A (Advantest Corp.), 23 March, 2001 (23.03.01), Par. Nos. [0026] to [0028]; Figs. 1 to 4 & DE 10031569 A1	6-8

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. <sup>7</sup> H01H 51/24 , H01H 50/18 ,	B 8 1 B 3 × 0 0		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. 7 H01H 50/00 - 59/00 , B81B	3, 400		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		<b>利用:市・ナ</b> マ	
引用文献の	ときは、その関連する箇所の表示	関連する   請求の範囲の番号	
Y     JP 6-84441 A (江刺正喜, 1994.03.25 全文, 全図 A	日本信号株式会社)	1, 3-8	
Y JP 7-176255 A (日本信号 1995. 07. 14 【0012】 【0046】~【0050】,図16&WO 95/17760 A1	$] \sim [0015],  \sim 4, 図15\sim16$	1, 3-8	
区 C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であってはなく、発明の原理又は近の理解のために引用するもの以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 25.11.03	国際調査報告の発送日 09.	12.03	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 岸 智章 電話番号 03-3581-1101	3X     9327       内線 3372	

	<del></del>		
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 7-193160 A (日本電気株式 1995.07.28 【0012】~【 (ファミリーなし)	:会社)	4
Y	JP 63-175450 A (株式会社日 1988.07.19 第3頁左上欄第3 (ファミリーなし)	立製作所) 行~第8行	4
Y	JP 2001-76605 A (株式会社 2001.03.23 【0026】~ 図1~4 & DE 10031569	[0028],	6-8